LKP41200DF系列 低噪声线性稳压器 产品说明书

LKP41200DF 系列 LDO 超低噪声线性稳压器

1 特点

- 输入电压范围: 4.5V~16V (LKP41200DF-02); 6.2V~16V (LKP41200DF-04)
- 输出电压范围: 1.5V~5.1V
- 最大输出电流: 800mA
- 压差: 0.6V(VOUT = 5V, 800mA 负载)
- 低噪声:
- 100Hz~100kHz 总积分噪声: 1.0μVRMS
- 10Hz~100kHz 总积分噪声: 1.6μVRMS
- 400 mA 负载下的电源抑制比(PSRR):
- >90dB(1 kHz \sim 100kHz, VOUT = 5V)
- >60dB(1MHz, VOUT = 5V)
- 在整个线路、负载与温度范围内的电压精度: ±2%
- 工作温度: -40℃~+125℃
- 封装: DFN8(3.00mm×3.00mm×0.75mm)

2 应用

对电源噪声敏感的应用:RF 混频器、锁相环

(PLL)、压控振荡器(VCO)和集成 VCO的 PLL

- 时钟分配电路
- 超声以及其他成像应用
- 高速 RF 收发器
- 高速、16 位以上的 ADC
- 通信和基础设施
- 电缆数模转换(DAC)驱动器

3 概述

LKP41200DF 是一系列超低噪声 LDO,采用 4.5V~ 16V 电源供电,最大输出电流为 800mA。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制(1kHz~100kHz 大于 90dB),使用一个 10 μ F 陶瓷输出电容,可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。使用两个电阻,输出电压可设为 1.5V~5.1V 范围内的任意电压值 。

器件信息

型号	封装	封装尺寸
LKP41200DF-02	DFN8	3.00m×3.00mm×0.75mm
LKP41200DF-04	DFN8	3.00m×3.00mm×0.75mm

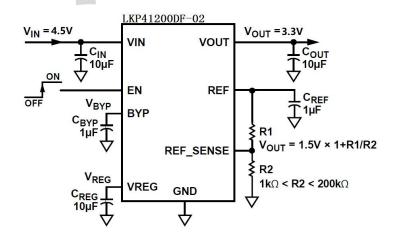


图 1 典型应用图

目 录

1 特点	1
2 应用	1
3 概述	1
4 管脚排布与功能描述	3
4.1 引脚排列	
5 电特性	3
5.1 绝对最大额定值	3
5.2 推荐工作条件	
5.3 热性能信息	4
5.4 电特性	4
6 特性曲线	
7 应用信息	6
7.1 功能结构	6
7.2 型号选择	7
7.3 输入/输出电容	7
7.4 输入和 VREG 电容	7
7.5 REF 电容	3
7.6 BYP 电容	8
7.7 输出电容和瞬态响应	8
7.8 使能(EN)和欠压闭锁(UVLO)	9
7.9 REF、BYP 和 VREG 引脚	9
7.10 限流和热过载保护	9
7.11 散热考虑	10
7.12 热特性参数(ΨJB)	10
7.13 布局注意事项	11
7.14 典型应用	11
8 封装形式 (DFN8)	12
9 机械、包装和可订购的信息	12
9.1 载带和卷盘信息	12
9.2 订货信息	14
10 版本信息	14

4 管脚排布与功能描述

4.1 引脚排列

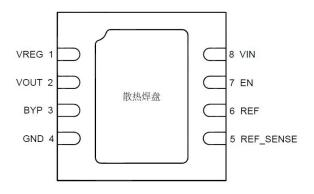


图 2 引脚排列图 (顶视图)

表 1 引脚说明

引脚编号	引脚名称	描述	引脚编号	引脚名称	描述
1	VREG	LDO 放大器的稳压输入电压。连接 至少 10μF 旁路电容到 GND。	5	REF_SEN SE	使用外部电阻分压器设置输出电压。 $V_{OUT}=1.5V imes \left(1+rac{R_1}{R_2} ight)$
2	VOUT	输出电压。连接至少 10μF 旁路电容 到 GND。	6	REF	低噪声基准电压输出。连接 1µF 旁路 电容至 GND。为提供固定输出电压, 将 REF_SENSE 短接到 REF。不要在 此引脚将负载接地。
3	ВҮР	低噪声旁路电容。连接一个 1μF 电容到 GND 以降低噪声,不要在此引脚将负载接地。	7	EN	使能端。高电平有效。若要实现自动 启动,请将 EN 接 VIN。
4	GND	接地端。	8	VIN	输入电压。连接至少 10μF 旁路电容 到 GND。
散热	焊盘	增强散热性能。为确保证	E常工作,应	Z将裸露焊盘:	连接至电路板的接地层。

5 电特性

5.1 绝对最大额定值

参数	数	最小值	最大值	单位
VIN 引脚电压	VIN	-0.3	18	V
REG 引脚电压	VREG	-0.3	VIN	V
VOUT 引脚电压	VOUT	-0.3	VREG	V
VOUT 与 BYP 引脚压差	V	-0.3	0.3	V
EN 引脚电压	VEN	-0.3	18	V
BYP 引脚电压	VBYP	-0.3	VREG	V
REF 引脚电压	VREF	-0.3	VREG	V
REF_SENSE 引脚电压	VREF_SENSE	-0.3	VREG	V

LKP41200DF

贮存温度	TSTG	-65	+150	℃
结温	Tj	1:	50	℃

注:

1.超过表中所列的绝对最大额定值可能会导致器件的永久损坏。长期处于绝对最大额定值的条件下可能会影响可靠性。任何时候都不建议对设备的功能操作超出推荐标准规定的条件。

5.2 推荐工作条件

	参数	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN	4.5	-	16	V
工作温度	TA	-55	-	+125	°C

5.3 热性能信息

, <u>— 130 1140</u>		
热指标	LKP41200DF	单位
7公1日47	8 个引脚	単 仏
R _{0JA} 结至环境热阻	42.1	°C/W
R _{θ JC(top)} 结至外壳(顶部)热阻	25.85	°C/W
ψ _{JB} 结至电路板特征参数	15.1	°C/W

5.4 电特性

(若无特殊说明,测试条件为 T_A = -40 $^{\circ}$ $^$

参数		最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
工作电源电流		_	4.3	7	mA	$I_{OUT} = 0\mu A$
工作电源电机	I _{GND}	9 –	9.6	12	mA	$I_{OUT} = 800 \text{mA}$
关断电流	I_{SD}	_	0.1	3	μΑ	$V_{EN} = GND$
输出电压精度	Vout	-2	_	+2	%	$V_{OUT} = V_{REF}$, $I_{OUT} = 10$ mA
		-2	_	+2	%	$1 mA \le I_{OUT} \le 800 mA$
电压调整率	$\Delta V_{OUT}/\Delta V_{IN}$	-0.01	_	0.01	%/V	$V_{IN} = 4.5V \sim 16V$, $I_{OUT} = 10mA$
负载调整率	$\Delta V_{OUT} / \Delta I_{OUT}$	_	0.5	1.5	%/A	$I_{OUT} = 1 \text{mA} \sim 800 \text{mA}$
V _{OUT} 限流阈值	I_{L_OUT}	1.0	1.3	1.6	A	-
压差	$ m V_{DRP}$	_	0.3	0.6	V	$I_{OUT} = 400 \text{mA}, V_{OUT}$ = 5V
D.左.	V DRP	_	0.6	1.2	V	$I_{OUT} = 800 \text{mA}, V_{OUT}$ $= 5V$
输入欠压阈值	$V_{ m UVLO}$	_	_	4.49	V	V _{IN} 上升
V _{REG} 欠压阈值	$V_{ m REGUV}$	_	_	3.1	V	V _{REG} 上升
EN 逻辑高电平	EN_H	3.2	_	_	V	4.5V <v<sub>IN<16V</v<sub>
EN 逻辑低电平	EN_L	_	_	0.8	V	4.5V <v<sub>IN<16V</v<sub>

EN 输入漏电流	$I_{\mathrm{EN_LK}}$	_	0.1	10	μA	V _{EN} = V _{IN} 或 GND

6 特性曲线

若没有其他说明, T_A=25℃

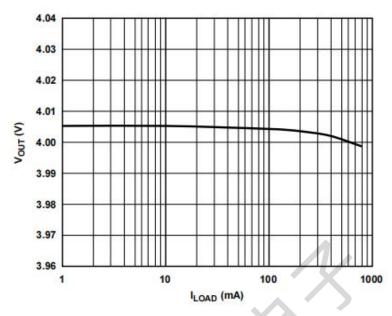


图 3 输出电压和负载电流关系曲线图(Vout=4V)

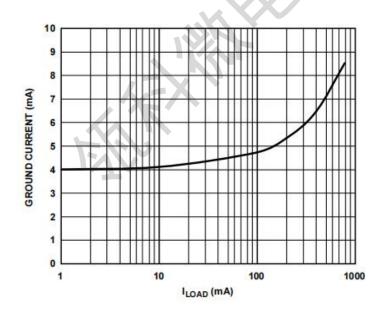


图 4 接地电流和负载电流关系曲线图(Vout=4V)

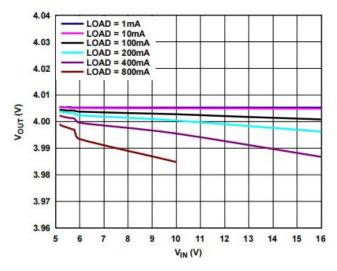


图 5 输出电压和输入电压关系曲线图(Vout=4V)

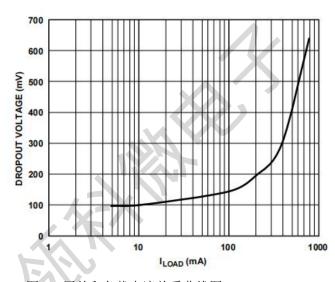


图 6 压差和负载电流关系曲线图(Vout=5V)

7 应用信息

7.1 功能结构

LKP41200DF 是一款针对射频(RF)应用的可调、超低噪声、高电源抑制比(PSRR)线性稳压器。输入电压范围为 4.5 V 至 16V,输出电流可达 800mA。功能框图如图 7

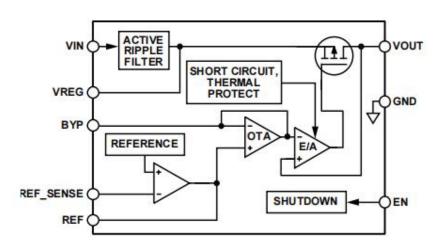


图 7 功能框图

7.2 型号选择

LKP41200DF 有两个型号,用户可根据具体应用选择。关于输入电压的型号选择指南如下表。

	VOUT		800 mA 负载	下的最低 VIN		1	400 mA 负载	下的最低 VIN	
型号	范围/V	VOUT<3.3V	VOUT<5V	VOUT≥3.3V	VOUT≥5V	VOUT<3.3V	VOUT<5V	VOUT≥3.3V	VOUT≥5V
LKP41200DF-0 2	1.5~4.0	4.5V	不适用	VOUT +1.2V	不适用	4.5V	不适用	VOUT +1 V	不适用
LKP41200DF-0 4	1.5~5.1	不适用	6.2V	不适用	VOUT +1.2V	不适用	6V	不适用	VOUT +1V

7.3 输入/输出电容

参数	符号	最小值	最大值	单位
•	CIN	7	-	
	CREG	7	-	
电容	COUT	7	-	μF
	СВҮР	0.1	-	
	CREF	0.7	-	
	CREG, COUT,	0.001	0.2	
电容等效串联电阻(ESR)	CIN, CREF	0.001	0.2	Ω
	CBYP	0.001	2.0	
注: 建议使	用 X7R 型和 X5R 型电容	、但不建议使用 Y	75V 和 Z5U 电容	

输出电容采用陶瓷电容,但只要注意等效串联电阻(ESR)值要求,便可以采用大多数常用电容。输出电容的 ESR 会影响 LDO 控制环路的稳定性。输出电容还会影响负载电流变化的瞬态响应。采用较大的输出电容值可以改善 LKP41200DF 对大负载电流变化的瞬态响应。

7.4 输入和 VREG 电容

在 VIN 至 GND 之间连接电容可以降低电路对 PCB 布局布线的敏感性,特别是遇到长输入走线或高信号源阻抗

时。 为了维持最佳的稳定性和 PSRR 性能,应在 VREG 与 GND 之 间连接电容。如果要求输出电容大于 $10~\mu F$,可选用更高的输入电容和 VREG 电容。

7.5 REF 电容

为使基准电压放大器保持稳定,必须使用 REF 电容。REF 与 GND 之间应连接电容。

7.6 BYP 电容

为了对基准电压缓冲器进行滤波,必须使用 BYP 电容。通常在 BYP 与 GND 之间连接电容。可以使用低至 0.1 μF 的电容,但是,LDO 的输出噪声电压会因此而提高。 此外,可以提高 BYP 电容以降低 1 kHz 以下的噪声,不过 LDO 的启动时间会延长。

7.7 输出电容和瞬态响应

输出电容的 ESR 影响稳定性,尤其是小电容。建议最小输出电容为 10μF, ESR 为 3Ω或更低,以防止振荡。 LKP41200DF 系列是一个小功率器件,输出瞬态响应将是输出电容的函数。较大的输出电容值可以减小峰值偏差,并为较大的负载电流变化提供更好的瞬态响应。

必须特别考虑陶瓷电容器的使用。陶瓷电容器是用各种介质制造的,每种介质在温度和施加电压下都有不同的性能。最常用的 Z5U、Y5V、X5R 和 X7R。Z5U 和 Y5V 适用于小封装的应用环境中,但它们往往具有强电压和温度系数,如图 8 和 9 所示。当与 5V 稳压器一起使用时,在工作温度范围内施加的直流偏置电压的有效电容值可低至 1μF 至 2μF。X5R 和 X7R 具有更稳定的特性,更适合用作输出电容。X7R 类型在温度范围内具有更好的稳定性,而 X5R 更便宜,可提供更高的值。X5R 和 X7R 指定工作温度范围和最大电容值随温度变化比 Y5V 和 Z5U 电容器好。随着元件外壳尺寸的增大,电容器的直流偏置特性趋于改善,但应验证工作电压下的预期电容。

电压和温度系数并不是问题的唯一来源。有些陶瓷电容器具有压电响应。由于机械应力,压电装置在其两端产生电压,类似于压电加速度计或麦克风的工作方式。对于陶瓷电容器,应力可以由系统中的振动或热瞬态引起。

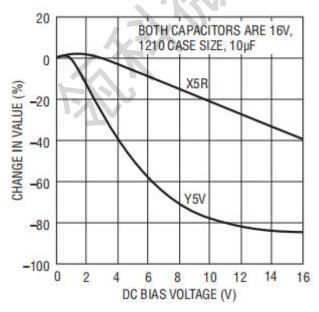


图 8 陶瓷电容器直流偏置特性

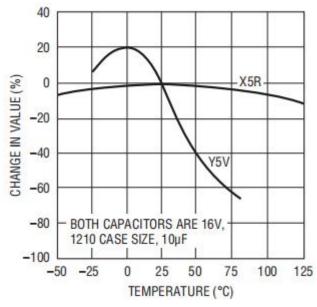


图 9 陶瓷电容器温度特性

7.8 使能(EN)和欠压闭锁(UVLO)

在正常工作条件下,芯片利用 EN 引脚使能和禁用 VOUT 引脚。当 EN 上的上升电压越过上阈值时,VOUT 开启。当 EN 上的下降电压越过阈值下限时, VOUT 关闭。迟滞随输入电压而变化。

芯片內置欠压闭锁电路, 当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时, 输出电压禁用。阈值上限和下限是固定值, 并具有迟滞。该迟滞可以防止输入电压上的噪声在经过阈值点时引起开关振荡。

7.9 REF、BYP 和 VREG 引脚

REF、BYP 和 VREG 是内部产生的电压,需要外部旁路电容才能正常工作。任何情况下都不能将任何负载连接到这些引脚,否则会影响芯片的噪声和 PSRR 性能。使用值较大的 CBYP、CREF 和 CREG 是允许的,但会增加启动时间。

7.10 限流和热过载保护

芯片内置限流和热过载保护电路,可防止功耗过大导致受损。当输出负载达到 1.3 A(典型值)时,限流电路就会起作用。当输出负载超过 1.3 A 时,输出电压会被降低,以保持恒定的限流值。

热过载保护电路将结温限制在 155°C(典型值)以下。在极端条件下(即高环境温度和/或高功耗),当结温开始升至 155°C以上时,输出就会关闭,从而将输出电流降至 0。当结温降至 140°C以下时,输出又会开启,输出电流恢复 为工作值。

考虑 VOUT 至 GND 发生负载短路的情况。首先,芯片的限流功能起作用,因此,仅有 1.3 A 电流传导至短路电路。 如果结的自发热量足够大,使其温度升至 155°C以上,热关断功能就会激活,输出关闭,输出电流降至 0。当结温冷却下来,降至 140°C以下时,输出开启,将 1.3 A 电流传导至短路路径中,再次导致结温升至 155°C以上。结温在 140°C至 155°C范围内的热振荡导致电流在 1.3 A 和 0 mA 之间振荡;只要输出端存在短路,振荡就会持续下去。 限流和热过载保护旨在保护器件免受偶然过载条件影响。为保证器件稳定工作,必须从外部限制器件的功耗,使结温不会超过 150°C。

7.11 散热考虑

在输入至输出电压差很小的应用中,芯片不会产生很多热量。然而,在环境温度很高和/或输入电压很大的应用中,封装发出的热量可能非常大,导致芯片结温超过最高结温 150°C。 当结温超过 155°C时,转换器进入热关断模式。只有当结温降至 140°C以下时,它才会恢复,以防永久性受损。因此,为了保证器件在所有条件下具有可靠性能,必须对具体应用进行热分析。芯片的结温为环境温度与功耗所引起的封装温升之和,如公式 2 所示。 为保证器件可靠工作,芯片的结温不得超过 150°C。 为确保结温低于此最高结温,用户需要注意会导致结温变化的参数。这些参数包括环境温度、功率器件的功耗、结与周围空气之间的热阻(θ JA)。θ JA 的值取决于所用的封装填充物和将封装 GND引脚和裸露焊盘焊接到 PCB 所用的覆铜数量。

表 2 给出了各种 PCB 覆铜尺寸时 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 LFCSP 封装的典型 θ JA 值。 表 3 给出了 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 LFCSP 封装的典型 Ψ JB 值。

	θ _{JA} (°C/W)				
覆铜面积(mm²)	8引脚 LFCSP	P 8引脚 SOIC			
25 ¹	165.1	165			
100	125.8	126.4			
500	68.1	69.8			
1000	56.4	57.8			
6400	42.1	43.6			

表 2 典型θJA 值

¹器件焊接在最小尺寸引脚走线上。

封装	Ψ _{JB} (°C/W)		
8引脚 LFCSP	15.1		
8引脚 SOIC	17.9		

表 3 典型ΨJB 值

结温可通过下式计算:

 $TJ = TA + (PD \times \theta JA)$ (1)

其中: TA 是环境温度。 PD 为芯片的功耗, 计算公式如下:

 $PD = [(VIN - VOUT) \times ILOAD] + (VIN \times IGND)$ (2)

其中: VIN 和 VOUT 分别为输入和输出电压。 ILOAD 为负载电流。 IGND 为接地电流。 接地电流引起的功耗相当小,可忽略不计。因此,结温的计算公式可简化为:

 $TJ = TA + \{ [(VIN - VOUT) \times ILOAD] \times \theta JA \}$ (3)

如公式 3 所示,针对给定的环境温度、输入与输出电压差和连续负载电流,为了确保结温不超过 150°C,对 PCB 存在一个最小覆铜尺寸要求。

7.12 热特性参数(ΨJB)

在已知板温的情况下,可以利用热特性参数(Ψ JB)来估算结温上升情况。最高结温(TJ)可由板温度(TB) 和功耗(PD) 通过下式计算:

 $TJ = TB + (PD \times \Psi JB)$ (4)

8 引脚 LFCSP 封装的ΨJB 典型值为 15.1° C/W。

7.13 布局注意事项

输入电容应尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚放置。输出电容应 尽可能靠近 VOUT 和 GND 引脚放置。VREG、VREF 和 VBYP 的旁 路电容应靠近相应的引脚和 GND。在板面积受限的情况下, 采用 0805、0603 或 0402 尺寸的电容可实现最小尺寸解决方案。

7.14 典型应用

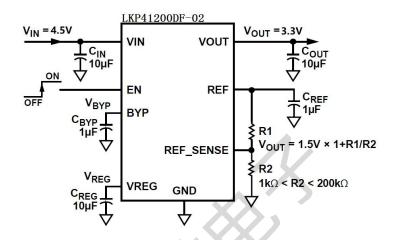


图 10 LKP41200DF-02 典型应用电路(输入电压 4.5-16V)

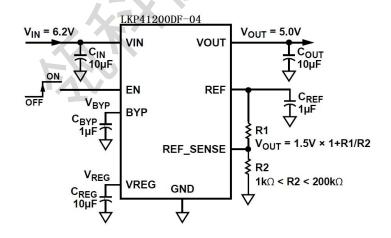
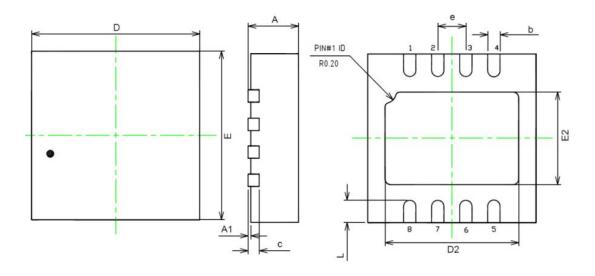


图 11 LKP41200DF-04 典型应用电路(输入电压 6.2-16V)

8 封装形式 (DFN8)

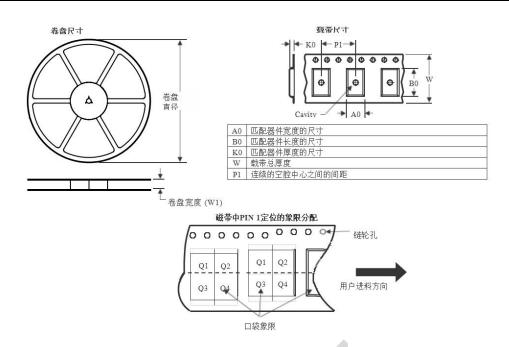


口一炸只	数值(单位: mm)				
尺寸符号	最小	公称	最大		
A	0.65	0.75	0.85		
A1	-	0.02	0.05		
b	0.20	0.25	0.30		
c	0.18	0.20	0.25		
D	2.70	3.00	3.30		
D2	2.18	2.38	2.58		
Е	2.70	3.00	3.30		
E2	1.45	1.65	1.85		
e	17	0.50BSC			
L	0.30	0.40	0.50		

9 机械、包装和可订购的信息

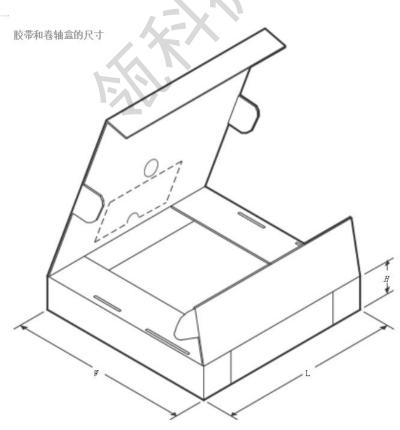
以下页面包括机械、包装和可订购的信息。

9.1 载带和卷盘信息



*所有尺寸均为标称尺寸

器件	封装	引脚数	卷盘直径(mm)	卷盘宽度 W1 (mm)	AO (mm)	BO (mm)	KO (mm)	P1 (mm)	W (mm)	引脚1象限
LKP41200DF-02	DFN8	8	330	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
LKP41200DF-04	DFN8	8	330	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2



*所有尺寸均为标称尺寸

瓴科微(上海)集成电路有限责任公司 Link Micro (Shanghai) Integrated Circuit Co., Ltd LkwI

LKP41200DF

器件	封装	引脚数	长度 (mm)	宽度(mm)	高度(mm)
LKP41200DF-02	DFN8	8	367.0	367.0	35.0
LKP41200DF-04	DFN8	8	367.0	367.0	35.0

9.2 订货信息

<u>LK</u>	<u>P</u>	<u>41200</u>	<u>DF</u>	<u>02</u>
1	2	3	4	5

- ① 产品系列代号
- ② 分类标识
- ③ 产品代号
- ④ 封装形式
- ⑤ 输入电压范围

4	俞入电压范围	表 4 订	货信息表	
	型号	封装	质量等级	工作温度
	LKP41200DF-02	DFN8,塑料封装	工业级	40°C +125°C
	LKP41200DF-04	DFN8,塑料封装	工业级	-40°C∼+125°C

10 版本信息

版本号	日期	版本说明	更改说明
REV 1.00	2024-07-08	更新版本	_